



## 第 9 章

电磁场与电磁波

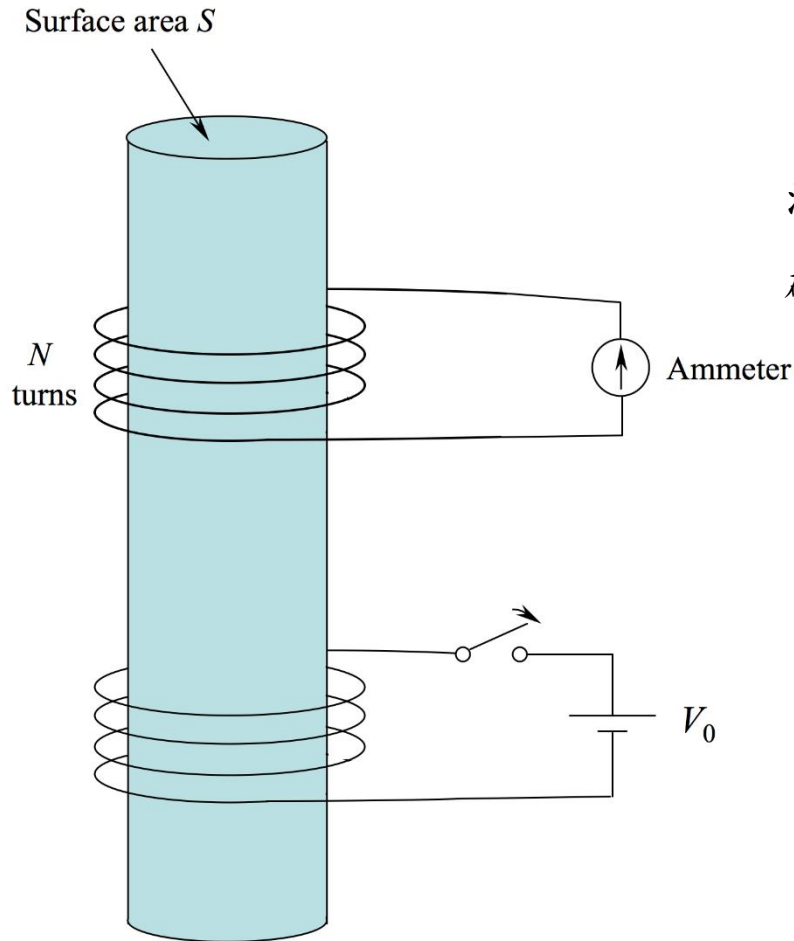
# 时变电磁场和麦克斯韦方程 Time-Varying Fields and Maxwell's Equations



9.1	法拉第定律
9.2	位移电流
9.3	微分形式的麦克斯韦方程组
9.4	积分形式的麦克斯韦方程组
9.5	推迟位



## 9.1 法拉第定律 FARADAY'S LAW



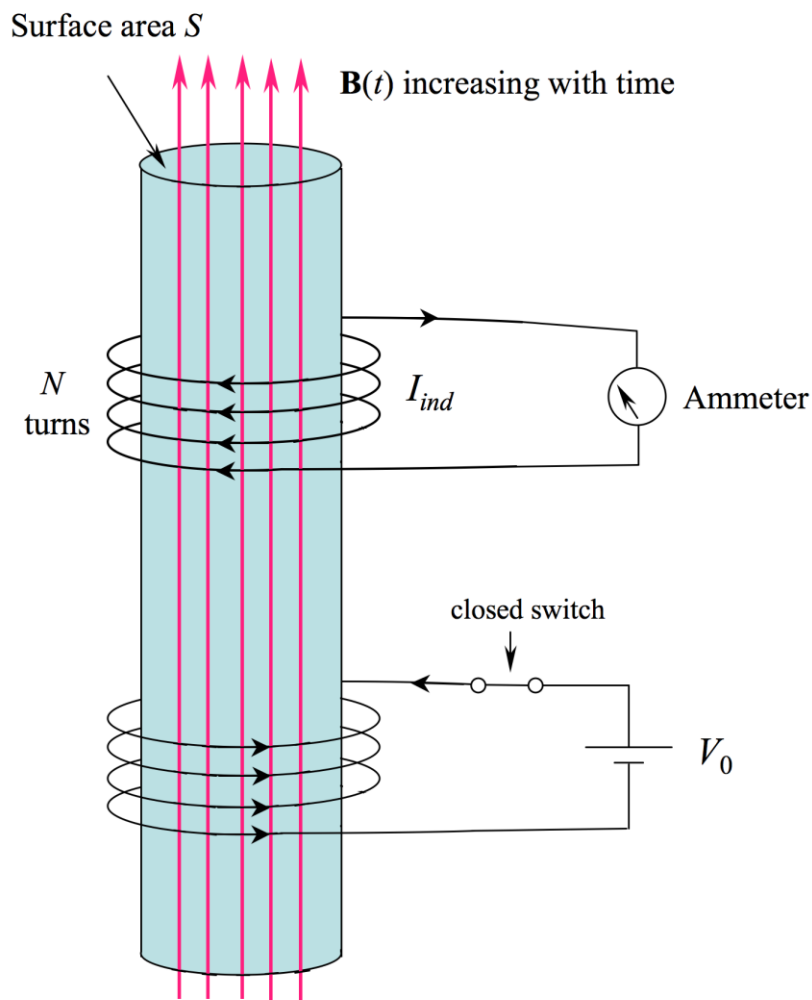
### 法拉第电磁感应实验

法拉第的问题：如果电流能产生磁场，那么  
磁场能产生电流吗？

法拉第为回答该问题设计了这样的实验。  
两组线圈绕在共用铁芯上。在下方的线圈  
中，通过闭合开关产生电流。在上面的线  
圈中，任何感应电流都由电流表记录。



## 9.1 法拉第定律 - 法拉第电磁感应实验

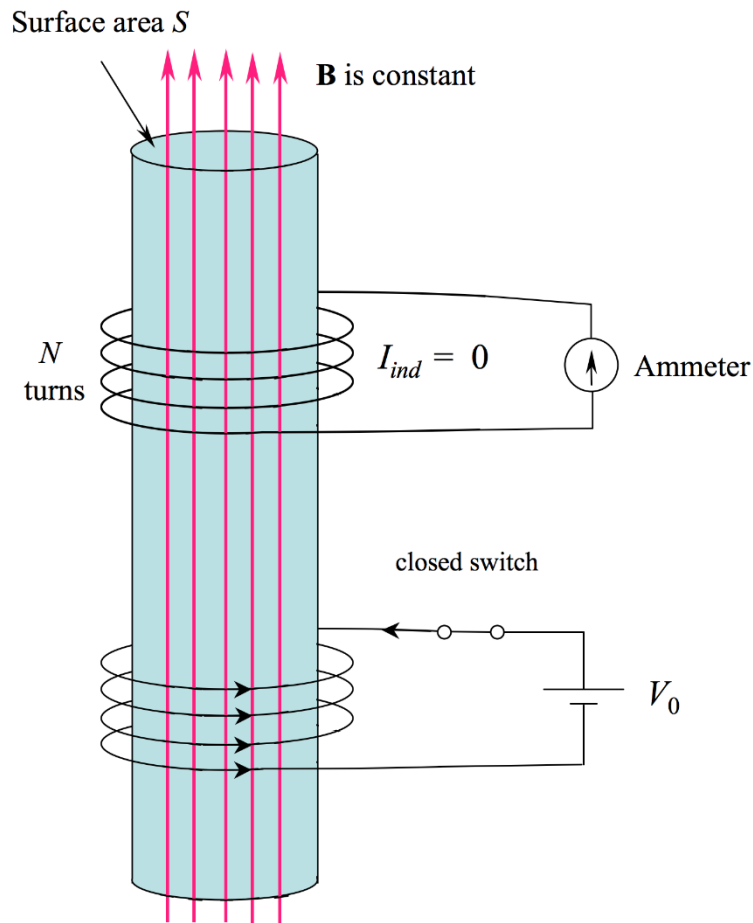


闭合开关会导致下方线圈中的电流随时间增加，并产生时变的磁通量密度  $\mathbf{B}$  与上方线圈交链。在  $\mathbf{B}$  随时间增加的阶段，在上方线圈的电流表中可检测到感应电流  $I_{ind}$ 。注意图中感应电流的方向和电流表的位置。

感应电流与磁通量（ $\mathbf{B}$  对  $S$  的表面积分）的时间变化率成正比。



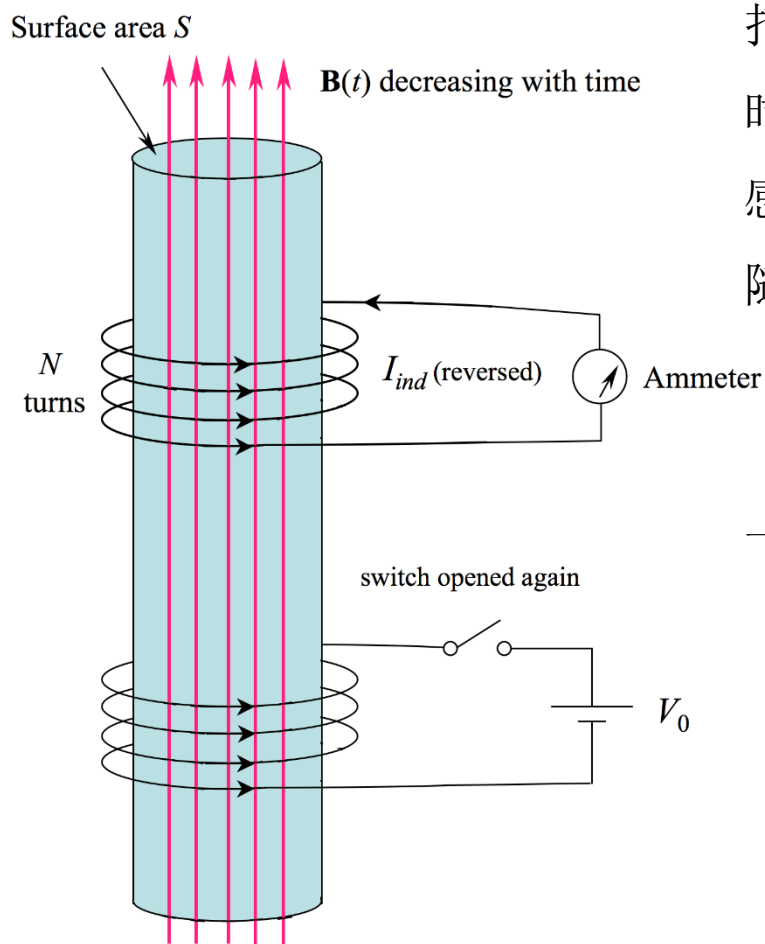
## 9.1 法拉第定律 - 法拉第电磁感应实验



一旦下方电路达到稳态，那么其中的  $\mathbf{B}$  将为恒定值，此时则发现感应电流为零。



## 9.1 法拉第定律 - 法拉第电磁感应实验



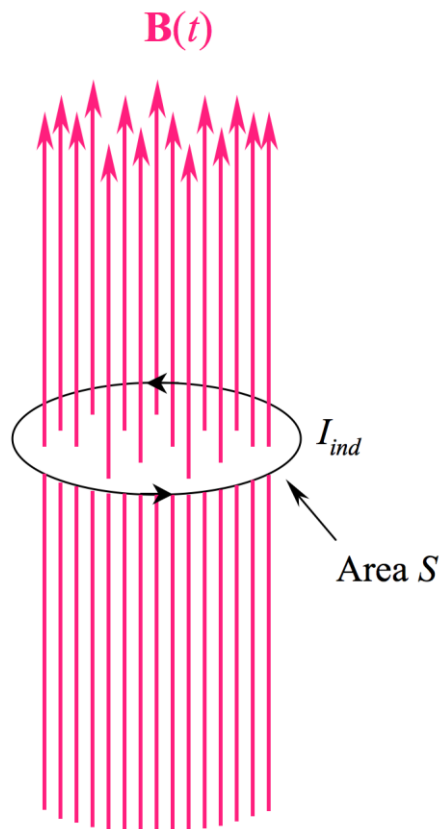
打开开关会导致电流在下方线圈中的电流随时间降低，磁通密度  $\mathbf{B}$  减少，而上方线圈的感应电流  $I_{ind}$  与之前相反。只要磁通量还在随时间减小，该电流就存在。

一旦  $\mathbf{B}$  完全减少到零，感应电流也为零。

电磁感应的应用：发电机、升降压、无线充电



## 9.1 法拉第定律

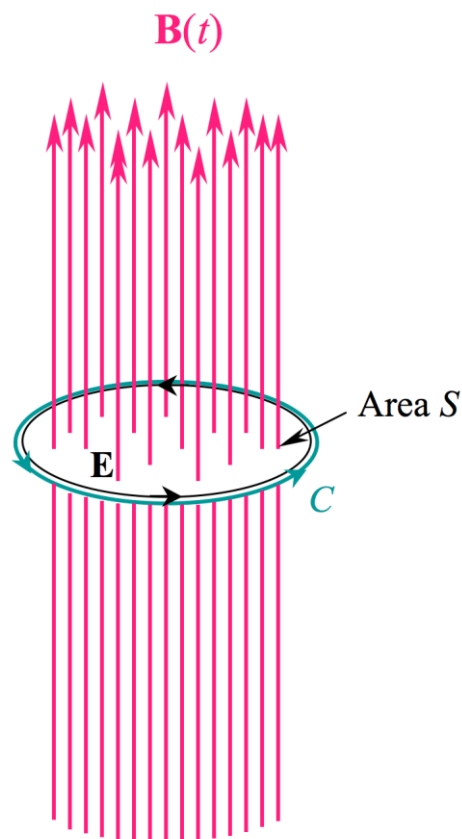


考虑一匝导线，其中存在外部施加的磁通量，且磁通量随时间变化。

由于磁通量的变化，线圈中会产生电流  $I_{ind}$ 。



## 9.1 法拉第定律

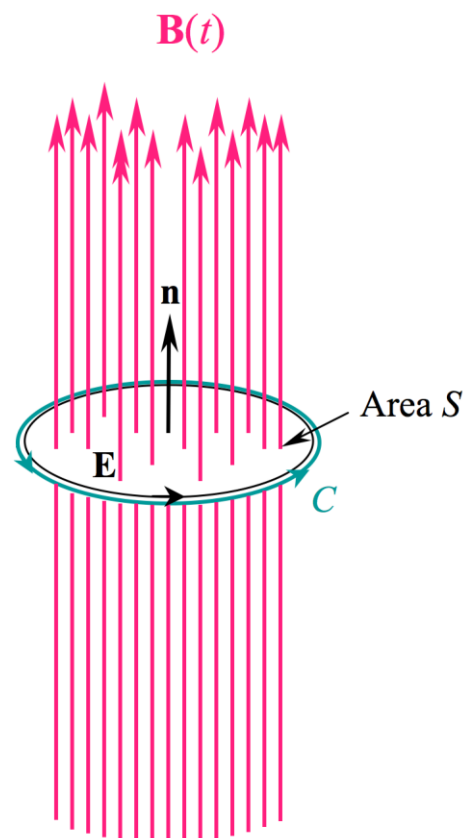


导线中的电流是由电场  $\mathbf{E}$  产生，它推动导线内的电荷运动形成电流。将图中的导线移除，而电场仍然存在，图中的积分路径  $C$  与  $\mathbf{E}$  重合。





## 9.1 法拉第定律



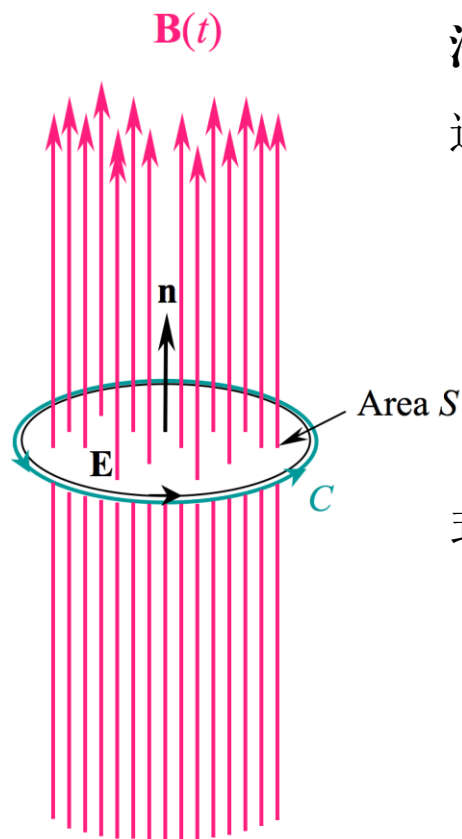
表面  $S$  的单位法向量为  $\mathbf{n}$ 。 $\mathbf{n}$  的方向由积分路径  $C$  按右手规则定义：四个手指绕着  $C$  的方向弯曲，右手拇指指向  $\mathbf{n}$  的方向

电动势  $emf$  定义为  $\mathbf{E}$  沿着路径  $C$  的闭合曲线积分：

$$emf = \oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{L}$$



## 9.1 法拉第定律



法拉第感应定律指出，闭合路径周围的感应电动势  $emf$  等于通过该路径所包围区域的磁通量的时间变化率：

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{L} = -\frac{d\Phi}{dt}$$

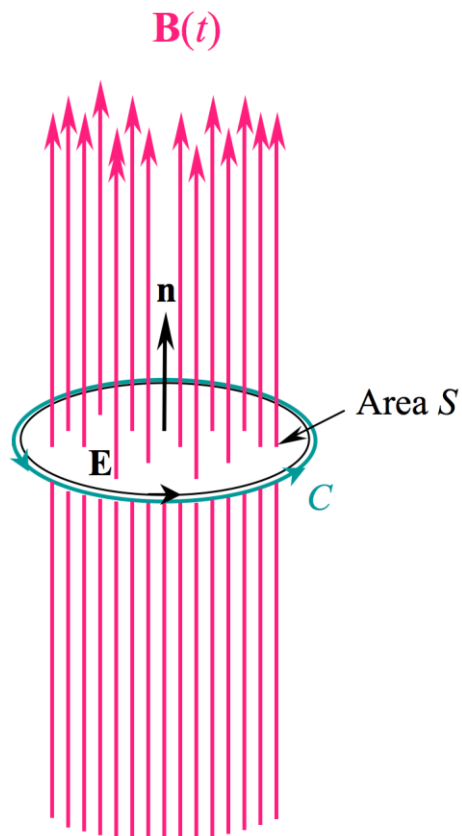
式中的磁通量为：

$$\Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \int_S \mathbf{B} \cdot \mathbf{n} da$$

注意这里使用了单位法向量，它决定了磁通量的符号，最终决定了电动势



## 9.1 法拉第定律



在这种情况下，根据电动势和磁通量的定义：

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{L} = -\frac{d\Phi}{dt}$$

得到：

$$\text{emf} = \oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{L} = -\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot \mathbf{n} da$$



## 9.1 法拉第定律 - 点形式

首先，将对时间的微分移入最右边积分内：

$$\Rightarrow \text{emf} = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{L} = - \int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$$

其次，用斯托克斯定理将  $\mathbf{E}$  的线积分改写为其旋度的表面积分：

$$\Rightarrow \int_S (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{S} = - \int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$$

注意到两个积分都针对同一表面，从而进行简化：

$$\Rightarrow (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{S} = - \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$$

最后，得到法拉第感应定律的点形式：

$$\boxed{\nabla \times \mathbf{E} = - \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}}$$



## 9.1 法拉第定律 – 计算时变磁场产生的电场

对于一个均匀分布但随时间变化的的磁场：

$$\mathbf{B} = B_0 e^{kt} \mathbf{a}_z$$

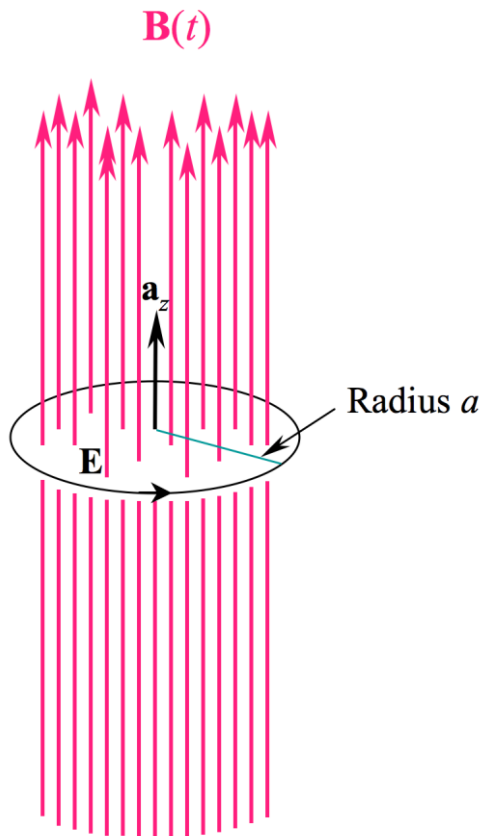
根据法拉第感应定律：

$$\text{emf} = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{L} = 2\pi a E_\phi$$

$$= - \int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} = -k B_0 e^{kt} \pi a^2$$

这个计算过程适用于任何半径的环路，那么可以用可变半径  $\rho$  替换固定半径  $a$  得：

$$\mathbf{E} = -\frac{1}{2} k B_0 e^{kt} \rho \mathbf{a}_\phi$$





## 9.1 法拉第定律 - 计算时变磁场产生的电场另一种解法

这次换用法拉第感应定律的点形式来计算  $\mathbf{E}$ :

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad \text{式中: } \mathbf{B} = B_0 e^{kt} \mathbf{a}_z$$

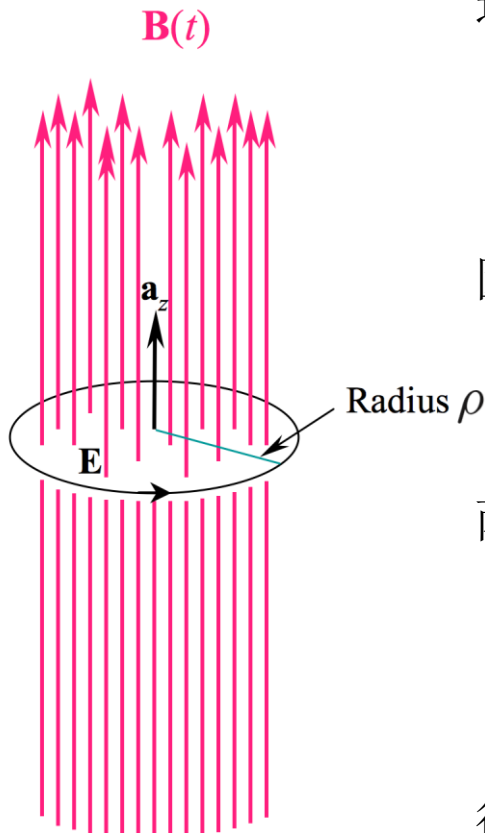
因有:  $(\nabla \times \mathbf{E})_z = -k B_0 e^{kt} = \underbrace{\frac{1}{\rho} \frac{\partial(\rho E_\phi)}{\partial \rho}}_{\text{书上公式 (7.25)}}$

仅存径向变化的  $z$  轴  
方向旋度分量

两边乘以  $\rho$  并对  $\rho$  积分得:

$$-\frac{1}{2} k B_0 e^{kt} \rho^2 = \rho E_\phi$$

得到同样的电场:  $\mathbf{E} = -\frac{1}{2} k B_0 e^{kt} \rho \mathbf{a}_\phi$





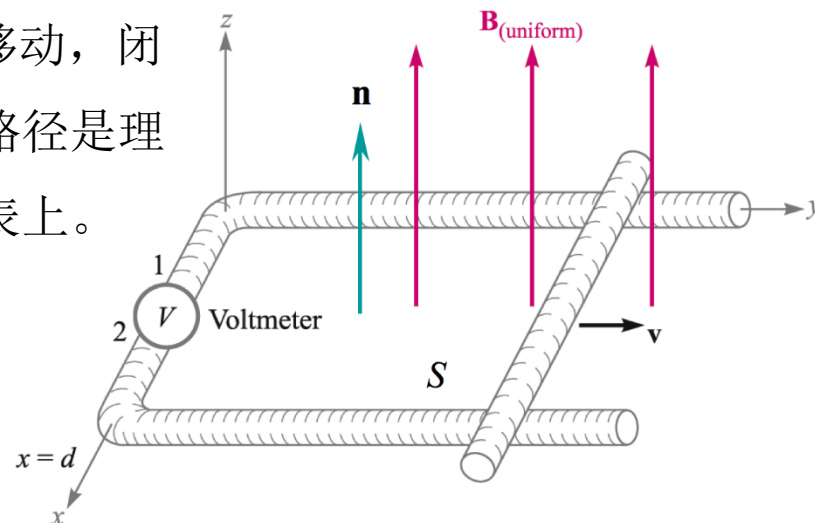
## 9.1 法拉第定律 – 移动路径的电动势

如图，由于长度为  $d$  的滑杆以恒定速度  $v$  移动，闭合路径内的磁通量随时间增加。假定导电路径是理想的，因此感应电动势完整的出现在电压表上。

导电路径所包围的磁通量为：

$$\Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \int_S \mathbf{B} \cdot \mathbf{n} da$$

$$\Phi = Byd \quad \text{式中 } y \text{ 随时间变化}$$



因此：

$$\text{emf} = -\frac{d\Phi}{dt} = -B \frac{dy}{dt} d = -Bvd$$



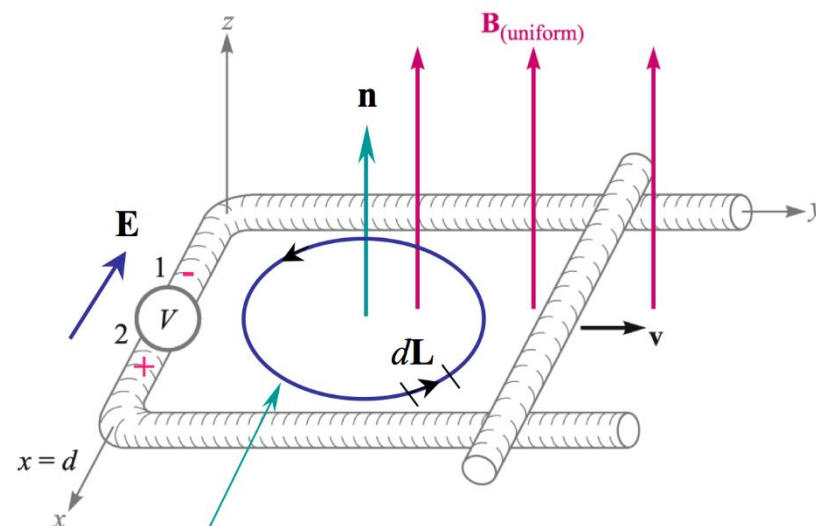
## 9.1 法拉第定律

已求得：

$$\text{emf} = -\frac{d\Phi}{dt} = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{L} = -Bvd$$

$\mathbf{E}$  的积分路径方向由右手法则确定（四个手指绕向闭合路径方向，右手拇指指向  $\mathbf{n}$  的方向），而  $d\mathbf{L}$  的方向如图所示。

从等式中可见  $\mathbf{E} \cdot d\mathbf{L}$  为负，这意味着  $\mathbf{E}$  将从电压表2端指向1端。传电路径是理想的，因此  $\mathbf{E}$  将仅存在于电压表上。



右手法则确定  $\mathbf{E}$  通过导体积分路径的方向





## 9.1 法拉第定律

滑杆包含自由电荷（电子），它们在穿过  $\mathbf{B}$  场时会受到洛伦兹力：

回顾：  $\mathbf{F} = Q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$

有：  $\frac{\mathbf{F}}{Q} = \mathbf{v} \times \mathbf{B}$

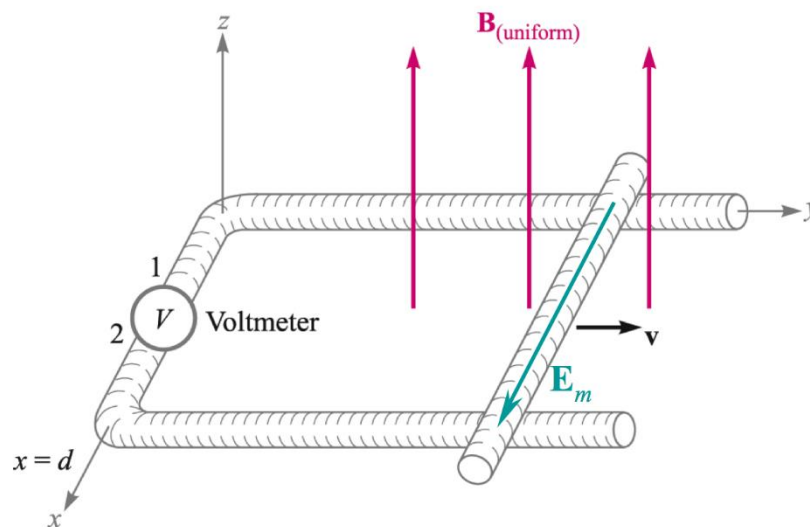
这个结果称为动生电场强度：

$$\mathbf{E}_m = \mathbf{v} \times \mathbf{B}$$

因此动生电动势是  $\mathbf{E}_m$  在与以前相同的路径上的闭合路径积分：

$$\text{emf} = \oint \mathbf{E}_m \cdot d\mathbf{L} = \oint (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{L}$$

注意，动生场强仅存在于运动中的电路部分





## 9.1 法拉第定律

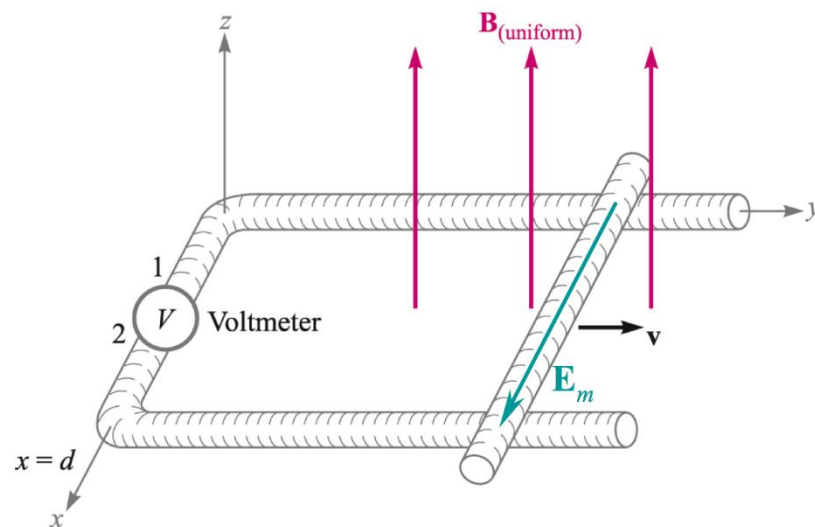
已知动生电动势为：

$$\text{emf} = \oint \mathbf{E}_m \cdot d\mathbf{L} = \oint (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{L}$$

当前的问题中变成：

$$\underbrace{\oint (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{L}}_{\text{路径积分}} = \int_d^0 v B dx = \underline{-Bvd} \quad \text{得到和前面相同的结果}$$

路径积分是根据右手规则确定，  
决定了这里的积分上下限顺序





## 9.1 法拉第定律

对于均匀恒定磁场中运动的导电路径，电动势完全由动生电动势组成：

$$\text{emf} = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{L} = \oint \mathbf{E}_m \cdot d\mathbf{L} = \oint (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{L}$$

当  $\mathbf{B}$  也随时间变化时，则需要考虑这两种作用对总电动势的共同影响：

$$\text{emf} = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{L} = \underbrace{- \int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}}_{\text{变压器电动势}} + \underbrace{\oint (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{L}}_{\text{动生电动势}}$$

上式也可以简化为：

$$-\frac{d\Phi}{dt}$$



## 9.2 位移电流 DISPLACEMENT CURRENT

已得到电场和磁场与旋度相关的两个方程：

$$\underbrace{\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}}_{\text{法拉第感应定律}} \quad \text{与} \quad \underbrace{\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}}_{\text{安培环路定律}}$$

取第二个方程的散度，得到一个恒为零的结果：

$$\nabla \cdot \nabla \times \mathbf{H} \equiv 0 = \nabla \cdot \mathbf{J}$$

然而，这与电流连续性方程不一致： $\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho_v}{\partial t}$  问题出在什么地方？



## 9.2 位移电流

假如在安培定律的右侧添加一个未知项  $\mathbf{G}$ :

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \mathbf{G}$$

再次对上式求散度:  $\nabla \cdot \nabla \times \mathbf{H} \equiv 0 = \nabla \cdot \mathbf{J} + \nabla \cdot \mathbf{G}$

其含义待明确

$$\underbrace{\nabla \cdot \mathbf{J}}_{\text{电流连续性方程}} = -\frac{\partial \rho_v}{\partial t} \quad \underbrace{\nabla \cdot \mathbf{G}}_{\text{必须为这个值}} = \frac{\partial \rho_v}{\partial t}$$

$$\text{用 } \mathbf{D} \text{ 表示: } \nabla \cdot \mathbf{G} = \frac{\partial \rho_v}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \cdot \mathbf{D}) = \nabla \cdot \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

可得:

$$\mathbf{G} = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

安培环路定律修正为:

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

$\mathbf{G}$  称为位移电流密度



## 9.2 位移电流

新的结果表明总电流由传导  
电流和位移电流组成：

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \mathbf{J}_d$$

其中位移电流密度为：

$$\mathbf{J}_d = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

传导电流密度为：

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E} \quad \text{欧姆定律}$$

若没有传导电流且电场随时间变化时：

$$\nabla \times \mathbf{H} = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad (\text{if } \mathbf{J} = 0)$$

注意上式与法拉第定律的对称性：

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$



## 9.2 位移电流 - 安培环路定律中的位移电流

通过选取适当的表面进行积分，可以通过位移电流密度计算得位移电流：

$$I_d = \int_S \mathbf{J}_d \cdot d\mathbf{S} = \int_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$$

对安培环路定律的旋度方程进行积分得：

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{S} = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} + \int_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$$

将斯托克斯定理应用于左侧，可得到熟悉的安培环路定律，但增加了位移电流项：

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{L} = I + I_d = I + \int_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$$



## 9.2 位移电流 - 位流电流的物理意义

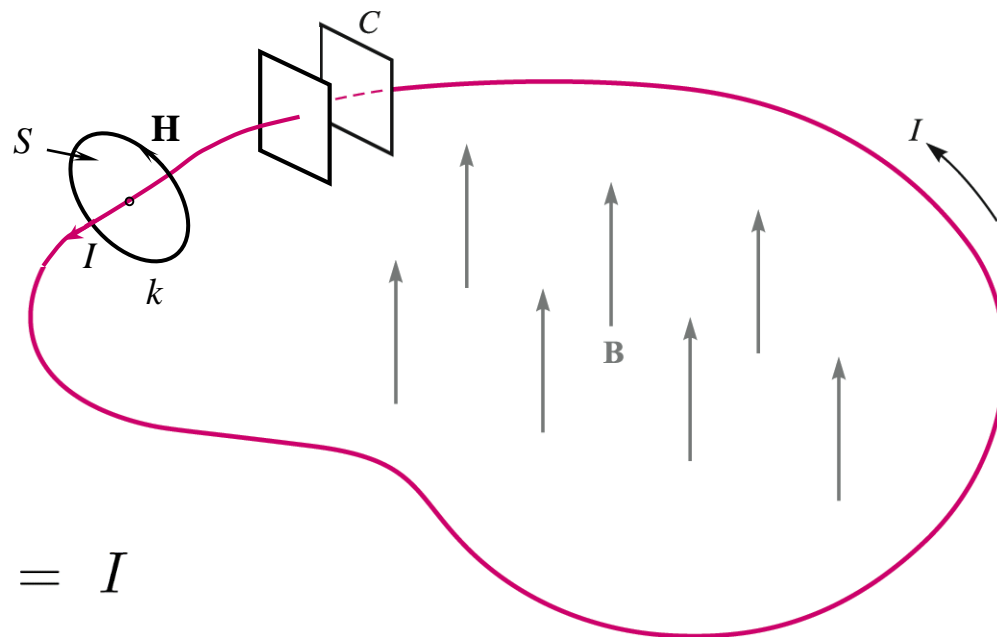
图中的电流回路包含一根细导线和平行板电容器，回路内部有一个时变的磁场

假定磁场随时间变化，因此它产生电动势，电动势又产生电流

暂时假设导线中存在传导电流  $I$ ，那么安培定律适用于图中的圆形路径由于，选取的环路半径与此处的导线长度相比非常小。因此，可以认为此处的导线很长且直，从而可得：

$$\oint_k \mathbf{H} \cdot d\mathbf{L} = \int \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = I$$

$$\Rightarrow \mathbf{H} = \frac{I}{2\pi\rho} \mathbf{a}_\phi$$



积分面是周长为  $k$  的圆形路径， $z$  轴方向为电流的方向



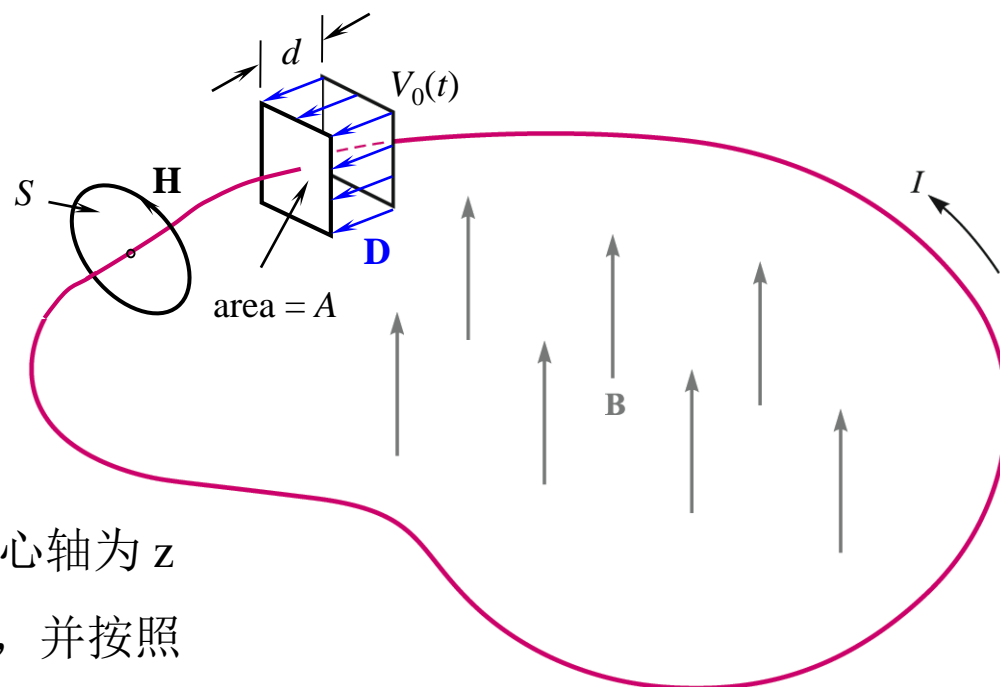


## 9.2 位移电流 - 位流电流的物理意义

当电流流动时，电容器中的电场将随时间变化，与电流沉积的平板电荷水平同步

电容器电压为  $V_0(t)$ ，以电容器中心轴为  $z$  轴，且使用自由空间的介电常数，并按照图示的电容尺寸，可计算得其中随时间变化的电通量为：

$$\Phi_e = \int \int \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \frac{\epsilon_0 A V_0(t)}{d}$$



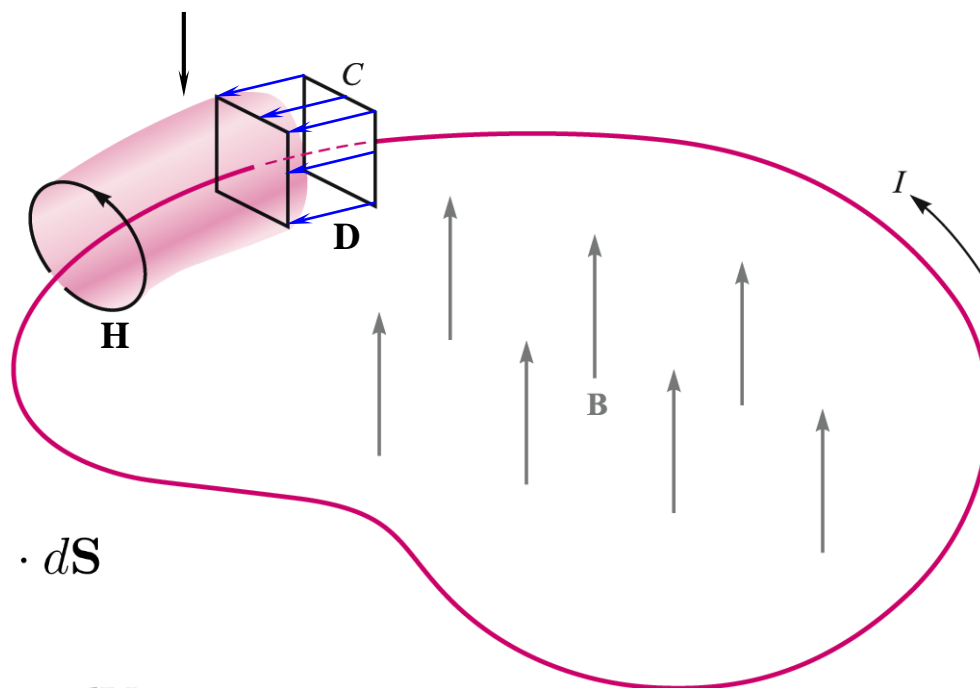


## 9.2 位移电流 - 时变电场等效电流即位移电流

拉伸的表面现在能够拦截电场线，并且没有传导电流

现在假设被原来的轮廓  $k$  所包围的表面  $S$  拉伸，使其能够截获电容器板之间的电场：

再次应用安培环路定律，但这次需要使用电容器中的位移电流：



$$\oint_k \mathbf{H} \cdot d\mathbf{L} = I_d = \int \int \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$$

$$= \frac{d\Phi_e}{dt} = \left( \frac{\epsilon_0 A}{d} \right) \frac{dV_0}{dt} = C \frac{dV_0}{dt}$$

结果必定与选择的表面无关，从而得出传导电流和位移电流必须相等的结论：



$$I = C \frac{dV_0}{dt}$$

熟悉的式子！



## 9.3 微分形式的麦克斯韦方程组

### MAXWELL'S EQUATIONS IN POINT FORM

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad \text{安培环路定律}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad \text{法拉第感应定律}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v \quad \text{电场中的高斯定律}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad \text{磁场中的高斯定律}$$



## 9.3 微分形式的麦克斯韦方程组 - 口诀

### MAXWELL'S EQUATIONS IN POINT FORM

**电磁学**

英·麦克斯韦

**法拉感应磁生电**

**安培环路电生磁**

**高斯定律皆散度**

**电通为  $\rho$  磁通零**



## 9.4 积分形式的麦克斯韦方程组 - 安培环路定律

### MAXWELL'S EQUATIONS IN INTEGRAL FORM

取点形式方程的曲面积分：

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{S} = \underbrace{\int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}}_I + \underbrace{\int_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}}_{I_d}$$

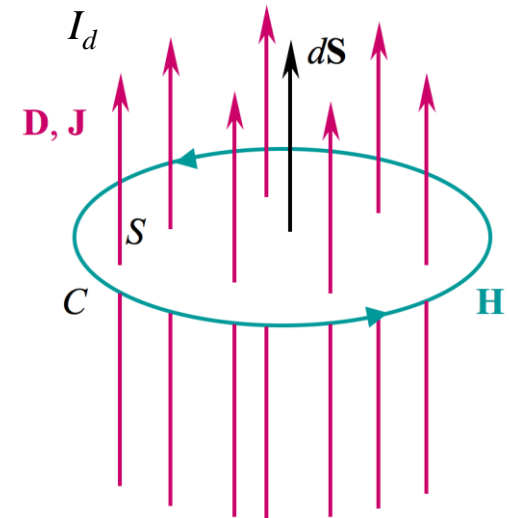
将斯托克斯定理应用于左侧：

$$\underbrace{\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{L}}_{mmf} = I + I_d$$

式中：

安培环路定律

$$I_d = \int_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} = \frac{d}{dt} \int_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \underline{\frac{d\Phi_e}{dt}}$$



使用右手规则确定路径  
方向和法向量的关系



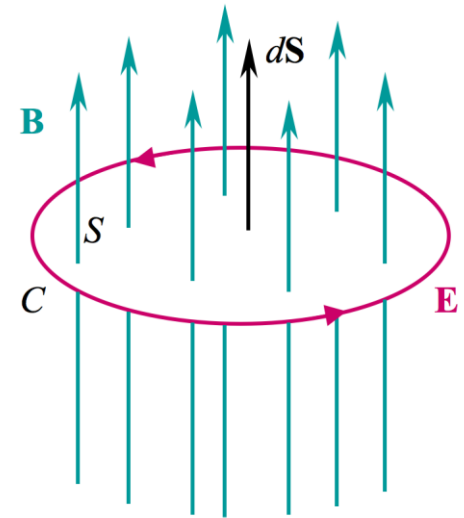
## 9.4 积分形式的麦克斯韦方程组 – 法拉第感应定律

取点形式方程的曲面积分：

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{S} = \int_S -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$$

将斯托克斯定理应用于左侧：

$$\underbrace{\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{L}}_{\text{emf}} = -\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = -\frac{d\Phi_m}{dt}$$



使用右手规则确定路径  
方向和法向量的关系



## 9.4 积分形式的麦克斯韦方程组 – 电场高斯定律

由：  $\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v$  两边对体积  $v$  进行积分：

$$\int_v \nabla \cdot \mathbf{D} dv = \int_v \rho_v dv = Q_{encl}$$

将散度定理应用于左侧：

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = Q_{encl}$$



## 9.4 积分形式的麦克斯韦方程组 – 磁场高斯定律

由：  $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$  两边对体积  $v$  进行积分：

$$\int_v \nabla \cdot \mathbf{B} dv = 0$$

将散度定理应用于左侧：

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$$





## 9.5 推迟位 THE RETARDED POTENTIALS

回顾电位和磁矢位

前面已定义了无时间变化条件下的标量电位和矢量磁位

标量电位（满足泊松方程）为：

$$V = \int_{\text{vol}} \frac{\rho_v dv}{4\pi\epsilon R} \quad (\text{static}) \qquad \nabla^2 V = -\frac{\rho_v}{\epsilon}$$

矢量磁位为：

$$\mathbf{A} = \int_{\text{vol}} \frac{\mu \mathbf{J} dv}{4\pi R} \quad (\text{dc}) \qquad \nabla^2 \mathbf{A} = -\mu \mathbf{J}$$

已知  $V$ , 可计算  $\mathbf{E}$ :

$$\mathbf{E} = -\nabla V \quad (\text{static})$$

已知  $\mathbf{A}$ , 可计算  $\mathbf{B}$ :

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \quad (\text{dc})$$



## 9.5 推迟位 - 与时变场麦克斯韦方程不一致

两边取旋度:  $\mathbf{E} = -\nabla V$

$$\nabla \times \mathbf{E} = \underbrace{\nabla \times (-\nabla V)}_{\text{该式恒为0!}} = \underbrace{-\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}}_{\text{该式不为0}}$$

对原方程进行修正, 添加一项  $\mathbf{N}$  场:

$$\mathbf{E} = -\nabla V + \mathbf{N}$$

再来计算旋度:

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0 + \nabla \times \mathbf{N} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$



## 9.5 推迟位 - 与时变场麦克斯韦方程不一致

已有：  $\nabla \times \mathbf{E} = 0 + \nabla \times \mathbf{N} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$

式中：  $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$

因此：  $\nabla \times \mathbf{N} = -\frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \mathbf{A})$

或：  $\nabla \times \mathbf{N} = -\nabla \times \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \Rightarrow \mathbf{N} = -\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$

修正后的适用于时变  $\mathbf{E}$  的表达式：

$$\mathbf{E} = -\nabla V - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$$



## 9.5 推迟位 - 验证是否满足其它麦克斯韦方程

现在必须验证： $\mathbf{E} = -\nabla V - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$  满足其他麦克斯韦方程

为此，首先将方程代入另一个麦克斯韦旋度方程（安培环路定律）：

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad \text{使用: } \begin{cases} \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} = \mu \mathbf{H} \\ \mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E} \end{cases}$$

得到：

$$\frac{1}{\mu} \nabla \times \nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{J} + \epsilon \left( -\nabla \frac{\partial V}{\partial t} - \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} \right)$$



## 9.5 推迟位 - 满足安培环路定律

已有：

$$\frac{1}{\mu} \nabla \times \nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{J} + \epsilon \left( -\nabla \frac{\partial V}{\partial t} - \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} \right)$$

使用矢量恒等式：

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{A} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}$$

得到：

$$\nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} = \mu \mathbf{J} - \mu \epsilon \left( \nabla \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} \right)$$



## 9.5 推迟位 - 满足高斯定律

接着：  $\mathbf{E} = -\nabla V - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$

必须满足：  $\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v$       式中：  $\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$

代入后得到：

$$\epsilon \left( -\nabla \cdot \nabla V - \frac{\partial}{\partial t} \nabla \cdot \mathbf{A} \right) = \rho_v$$

最终得到：  $\nabla^2 V + \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \mathbf{A}) = -\frac{\rho_v}{\epsilon}$



## 9.5 推迟位 - 整合结果

$\mathbf{A}$  与  $V$  之间的关系，根据安培环路定律有：

$$\nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} = \mu \mathbf{J} - \mu \epsilon \left( \nabla \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} \right)$$

根据高斯定律有：

$$\nabla^2 V + \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \cdot \mathbf{A}) = -\frac{\rho_v}{\epsilon}$$



## 9.5 推迟位 - 洛伦茨规范条件

若要完全确定一个矢量场，必须同时给定其散度、旋度以及它在某个点（可能位于无穷远）的值。已指定矢量位  $\mathbf{A}$  的旋度为  $\mathbf{B}$ ，所以现在可以自由地指定散度，以使方程在实际情况下合理且可解。因此，可以任意地规定  $\mathbf{A}$  的散度。为了便于简化上页中的两个式子。

鉴于上述原因，将  $\mathbf{A}$  的散度指定如下：

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = -\mu\epsilon \frac{\partial V}{\partial t}$$

该式称为洛伦茨规范条件，这种规范具有洛伦兹不变性

丹麦物理学家路德维希·  
洛伦茨 (Ludvig Lorenz)

荷兰物理学家亨德里克·洛  
伦兹 (Hendrik Lorentz)





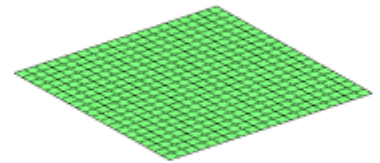
## 9.5 推迟位 - 波动方程

根据洛伦茨规范条件:  $\nabla \cdot \mathbf{A} = -\mu\epsilon \frac{\partial V}{\partial t}$



这两个方程通过以下方式简化:

$$\nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} = \mu \mathbf{J} - \mu\epsilon \left( \nabla \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} \right)$$



变为:

$$\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu \mathbf{J} + \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2}$$

$$\nabla^2 V + \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \cdot \mathbf{A}) = -\frac{\rho_v}{\epsilon}$$

变为:

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho_v}{\epsilon} + \mu\epsilon \frac{\partial^2 V}{\partial t^2}$$

### 达朗贝尔方程

这些都是波动方程，它们的解为传播函数，此主题将在后续章节中详细讨论



## 9.5 推迟位 - 对电位和磁矢位的修正

时变场的最终效果是，它的影响（电位、力或它们的存在）将在一段时间延迟后被感觉到。该延迟与场源和观察点之间的距离成正比，代表着“扰动”在这两点之间传播所需的时间。因此，需要对以前标量位和矢量位的积分式进行修正，以使用更简单的方式表示这种延迟。

<u>静态位</u>				<u>推迟位</u>
$V = \int_{\text{vol}} \frac{\rho_v dv}{4\pi\epsilon R}$	$\Rightarrow$	$V = \int_{\text{vol}} \frac{\rho_v (t - R/v_p)}{4\pi\epsilon R} dv$		
$\mathbf{A} = \int_{\text{vol}} \frac{\mu \mathbf{J} dv}{4\pi R}$	$\Rightarrow$	$\mathbf{A} = \int_{\text{vol}} \frac{\mu \mathbf{J} (t - R/v_p)}{4\pi R} dv$		

$v_p$  是“传播速度”（不要与体积混淆）

$V$  和  $\mathbf{A}$  现在是传播函数。

式中的括号项： $(t - R/v_p)$  表示距离  $R$  越远，感受到电位的延迟时间  $t$  越长。



# 习题

课堂：9.4, 9.12

课后：9.1, 9.3, 9.5

在黑板上  
写下正确的  
麦克斯韦方程组

